

# Silicon NPN Transistor

## **TE13007**

700V / 8A

# DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1985&89

## TE 13006 · TE 13007

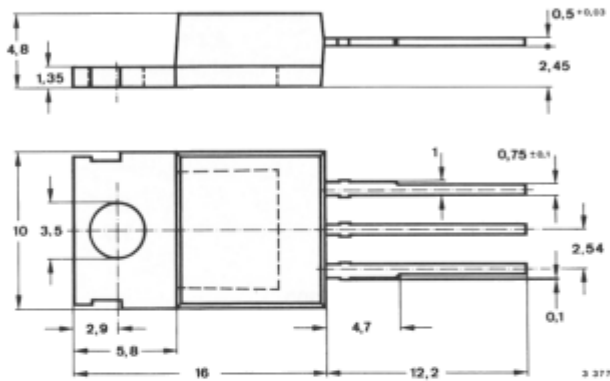
### Silizium-NPN-Leistungstransistoren

**Anwendung:** Schaltnetzteile, Lampenansteuerschaltungen

**Besondere Merkmale:**

- In Dreifachdiffusions-Technik
- Kurze Schaltzeit
- Glaspassivierung
- Verlustleistung 100 W
- Hohe Sperrspannung

**Abmessungen in mm**



Kollektor mit  
Montagefläche verbunden

Normgehäuse:  
14 A 3 DIN 41869  
JEDEC TO 220  
Gewicht max. 2.5 g

**Zubehör**

Isolierscheibe Best. Nr. 564542

**Absolute Grenzdaten**

		TE 13006	TE 13007	
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	$U_{CEO}$	300	400	V
	$U_{CES}$	600	700	V
Emitter-Basis-Sperrspannung	$U_{EBO}$	9		V
Kollektorstrom	$I_C$	8		A
Kollektorspitzenstrom	$I_{CM}$	16		A
Basisstrom	$I_B$	4		A
Basispitzenstrom	$I_{BM}$	8		A



## TE 13006 · TE 13007

## Schaltzeiten

Ohmsche Last Fig. 3

 $U_S = 125 \text{ V}, I_C = 5 \text{ A},$  $I_{B1} = -I_{B2} = 1 \text{ A},$  $t_p = 25 \mu\text{s}, \frac{t_p}{T} \leq 0.01$ 

Einschaltzeit

 $t_{on}$ 1.1  $\mu\text{s}$ 

Speicherzeit

 $t_s$ 3.0  $\mu\text{s}$ 

Abfallzeit

 $t_f$ 0.7  $\mu\text{s}$ 

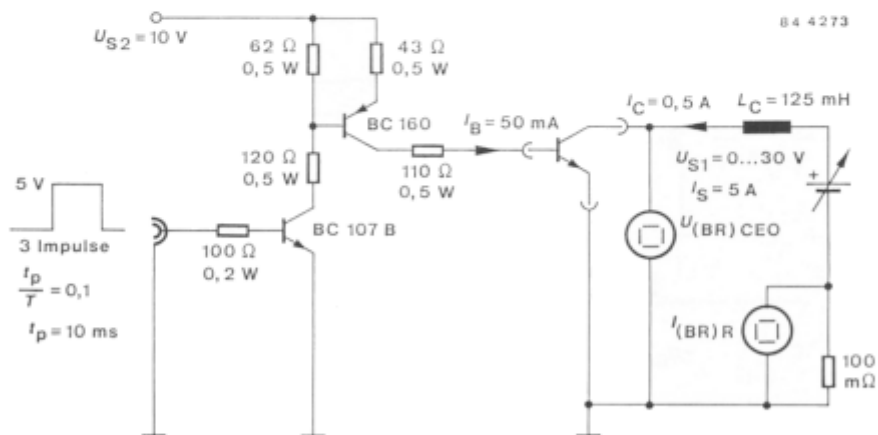
Induktive Last Fig. 4, 5

 $I_C = 5 \text{ A}, I_{B1} = 1 \text{ A},$  $U_{klemm} = 300 \text{ V}, U_{BEoff} = 5 \text{ V}, T_{case} = 100 \text{ }^\circ\text{C}$ 

Speicherzeit

 $t_{sv}$ 2.3  $\mu\text{s}$ 

Abschaltbelastungszeit

 $t_c$ 0.7  $\mu\text{s}$ Fig. 1 Meßschaltung für:  $U_{(BR)CEO}$

**TE 13006 · TE 13007**

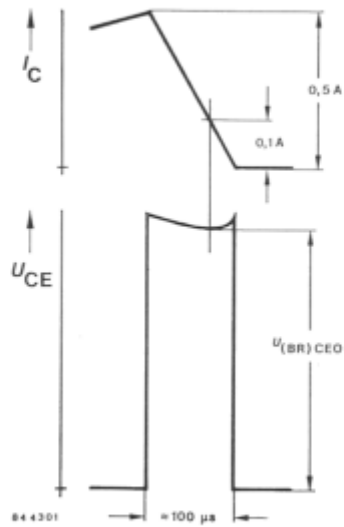


Fig. 2 Impulsdiagramm

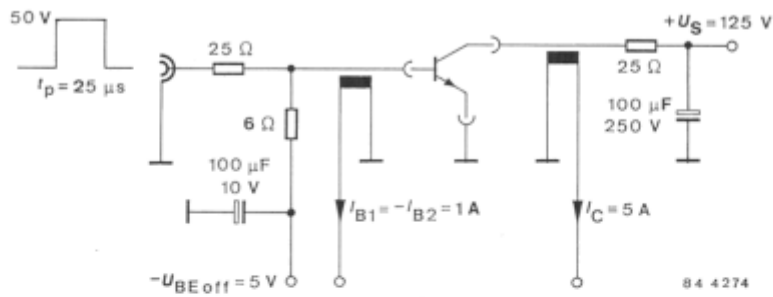


Fig. 3 Meßschaltung für: Schaltzeiten mit ohmscher Last

TE 13006 · TE 13007

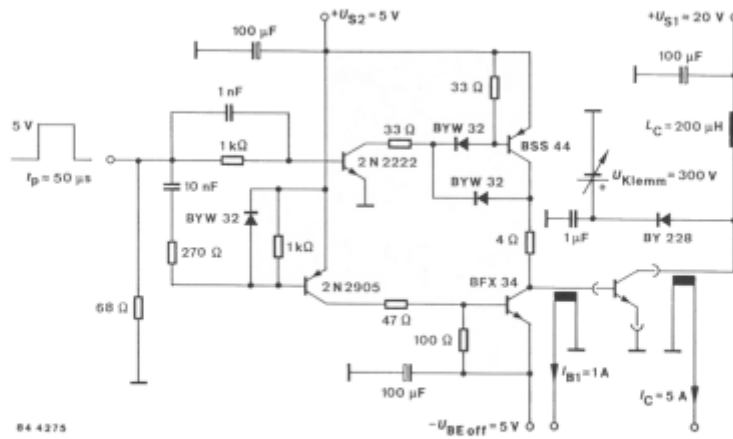


Fig. 4 Meßschaltung für: Schaltzeiten mit induktiver Last

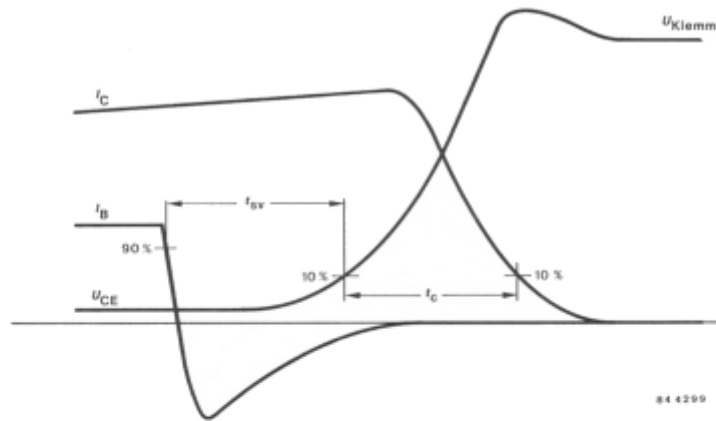


Fig. 5 Impulsdiagramm